









	<h2 style="color: red;">SIR812DP-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIR812DP-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8
	Datenblätter:  SIR812DP-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 4482 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR812DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	4482 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.45 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	6.25W (Ta), 104W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10240pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	335nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIR812DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR812DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR812DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIR812DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR804DP-T1-GE2 VISHAY VISHAY QFN-8</p>	 <p>SIR804DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR808DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 20A POWERPAK</p>	 <p>SIR818DP VISHAY SIR818DP VISHAY</p>
 <p>SIR808DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 20A POWERPAK</p>	 <p>SIR812DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR814DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR814DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>

SIR812DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SIR812DP-T1-GE3	SIR812DP-T1-GE3	SIR812DP-T1-GE3	SIR812DP-T1-GE3	SIR812DP-T1-GE3
SIR812DP-T1-GE3 / Siliconix	SIR812DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR812DP-T1-GE3 -Datenblätter	SIR812DP-T1-GE3 PDF	SIR812DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix
SIR812DP-T1-GE3 Electronic	SIR812DP-T1-GE3 -Komponenten	SIR812DP-T1-GE3 -Verteiler	SIR812DP-T1-GE3 -Bild	SIR812DP-T1-GE3 -Teil
SIR812DP-T1-GE3 Preis	SIR812DP-T1-GE3 Hersteller	SIR812DP-T1-GE3 Bild	SIR812DP-T1-GE3 Aktie	SIR812DP-T1-GE3 Inventar
SIR812DP-T1-GE3 Neu	SIR812DP-T1-GE3 Original	SIR812DP-T1-GE3 garantiert	SIR812DP-T1-GE3 RFQ	SIR812DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited